氧化钨薄膜电致变色状态下物相组份 及表面形貌变化的研究

王晓光 江月山 杨乃恒

(东北大学真空工程系, 沈阳 110006)

袁 磊 庞世瑾

(中国科学院北京真空物理开放实验室,北京100080)

文 摘:通过对直流磁控溅射方法得到WO x 膜层的电化学和光学性能测试,以及 XRD 和 STM 的物相、形貌分析,发现该WO x 膜层具有良好的电致变色性能,原始沉积态WO x 膜层为非晶态,其着退色状态仍为非晶特性,而晶态WO x 膜层在着色态和退色态之间发生物相组份的可逆变化,且表面形貌有很大差异。

关键词: 电致变色 (EC), 物相组份, 表面形貌

0 引 言

电致变色 (Electrochromics , 简称 EC) 薄膜由于具有可连续改变可见光在薄膜中透射率 的性能, 因此在无视角差显示器件、汽车后视防眩镜, 以及有自动调节光强和热屏蔽节能要 求的车, 船、飞机及建筑用玻璃窗领域具有广范应用前景, 其研究开发工作正日益深入^{(1,2})。然 而, 由于对薄膜电致变色机理尚不十分清楚, 因此给制备实用的 EC 薄膜器件带来困难。薄膜 电致变色状态的可逆变化应与薄膜所属物相的变化相关联。研究表明, WO _x 薄膜的 EC 效应 是由于薄膜晶体化合物中的氧离子缺损, 导致电场作用下的电子空位填充, 形成色心^{(3,4})。 Cranqvist 在有关金属氧化物 EC 薄膜价带理论模型的研究中指出, 如将物相晶体结构和晶体 场理论与已有的研究结果相结合, 将会使人们对电致变色机理的认识进一步深入⁽⁵⁾许多研究 报告亦对有关技术制备的 EC 薄膜的相关性能进行了讨论⁽⁶⁻⁸⁾。但是在 EC 薄膜的组份及形貌 研究上, 尤其是 EC 过程中, 着色态与退色态可逆转变所相关的薄膜物相组份和表面形貌性质 的研究仍不多见。由于 WO _x 薄膜具有很高的变色效率,本文以其为对象,用 X-ray 衍射 (XRD)和扫描隧道显微镜 (STM) 技术,对其着退色状态的物相组份,所属晶系及相应表面 微形貌进行了研究。

1 实验方法

1.1 样品制备

WO x 薄膜用直流磁控溅射方法制得, 平面靶为纯度 99.9% 金属钨, 面积 180cm², 真空室

本底真空优于 3×10^{-3} Pa 工作压强 2Pa, 工质气体为高纯O₂ 和高纯Ar, Po₂ P_{Ar}=8 2, 靶极功率为 375W; 基片是镀有 FTO (SnO₂ F) 膜的玻璃片, 方阻值 2Q/ , 可见光透过率为 80%, 基片面积 $3cm^2$, WO x 薄膜沉积厚度约 2×10^{-7} m。

1.2 电化学性能与光学性能测试

WO x 薄膜试样的电致变色化学反应是参照文献 [9]的方法在两极电解槽中进行, 镀有 WO x 薄膜的试片为工作电极, 高纯石墨片为对电极,0 . 25*M* HCl 溶液为电解液, 在两电极间 施加 IV 和-1 V 的交变方波电压(周期为 98s),进行WO x 薄膜的着色和退色反应。当经过 200 次循环后,将着色态(或退色态)试样从电解液中取出,用去离子水冲洗干净;经热风吹 干,放到Leng -Gang 721 型分光光度计测量室,以镀有 FTO 膜的基片为参比片,进行可见光 透射光谱测量,波长范围为 360nm—800nm (见图 1)。

1.3 物相组份的 XRD 测定及表面形貌的 STM 分析

用 X-ray 衍射膜层分析法,对 FTO 基片和着退色状态的WO x 膜层进行物相分析, X-ray 为 Cu 靶 Ka1 标识线, 波长为 0.1548nm, 各试样膜层及相关状态的 X-ray 衍射谱见图 2—4。用 CSTM -9000 型扫描隧道显微镜,对有关样品进行表面微形貌分析,采用恒流扫描模式,在 大气、室温状态下进行测量,以机械剪切的铂-铱丝为针尖,所加偏压与隧道电流随样品的电 致变色状态不同而不同。试样表面在扫描前经过净化处理,方法与试样进行透射光谱测试前 的步骤相同。

2 实验结果与讨论

图 1 所示是原始沉积态WO x 薄膜试样和经加热后处理 (200 ,1 h)的WO x 薄膜试样的 着色态和退色态可见光透射光谱曲线。从图 1 可知, 原始沉积态WO x 和经加热后处理的WO x 薄膜均具有电致变色效应, 但前者的着退色态透射率变化值 (Δ*T*%)大于后者的同类性能指标。图 2 所示是 FTO 基片的 XRD 图谱。





图 1 WO x 膜层的着色态与退色态透射光谱曲线 (a)、(b)原始沉积态(c)、(d)经加热后处理

2



图 3 所示是原始沉积态WO x 薄膜的着色态和退色态的 XRD 图谱 (其中原始沉积态WO x 的 XRD 图谱与其退色态时相同)。从图 3 可见,原始沉积态WO x 膜层为非晶物相 (a WO x), 其着退色状态时亦为非晶特性。将原始沉积态WO x 薄膜试样加热后处理,得到晶态WO x (cWO_x) 膜层,见图4(a)。从该图可知,加热后的薄膜为晶态化学计量三斜晶系的WO₃,将 其进行着色处理后,其XRD 谱为图4(b),它主要与晶态非化学计量四方晶系的HussWO3相 对应,如将已着色的H0.33WO3 膜层处理成退色状态,其XRD 图谱同图4 (a),即又转变为化 学计量三斜晶系的WO3,这种物相组份的可逆转化随晶态 cWOx 膜层的着退色状态的变化 而变化。



加热处理后的WO x 试样着退色状态的 XRD 谱 图 4

(a) 着色态 (b) 退色态

通过 XRD 图谱的晶面间距, 计算出相应的点阵参数。 对退色态化学计量WO3 薄膜: a= $\times 10^{-10}$ m, c=3.7958 $\times 10^{-10}$ m, c=89.38 7.2944 $\times 10^{-10}$ m, b=7.4855 °, β=90.42 °. Y ? 对着色态非化学计量H 0.33WO 3 薄膜, a= b=5.33 $\times 10^{-10}$ m, c=3.7882 $\times 10^{-10}$ m. =90.8 α= β= ¾90 °° 实际上, WO x 膜层着退色状态的物相组份应为混合相, 在退色处理后的WO ₃ 膜层中会有微量 H_xWO_x (0 < x < 0.1)相,但并未引起WO₃ 膜层的物相衍射峰变动;在着 色处理后的HossWOs 膜层中亦有HossWOs 物相存在. 这从相应的XRD 谱图中可以看出。本 实验着色处理后的H₃WO³物相中,主要为H₀₃₃WO³相,经过着色膜层的RBS 分析及三电极 伏安曲线测试,得出膜层的相对密度和着退色反应时的进出电荷量o,结合文献[10]的方法, 2

计算得出H_xWO₃中的 x =0.323

由于晶态 c-WO x 薄膜具有这种物相组份及点参的可逆变化,因此用 STM 技术对其表面 微形貌进行分析。图 5 所示是着色态H_{0.33}WO 3 膜层的表面微形貌像 (V_{bia} =0.275 V, I_{ref} =-1.20 nA。图 6 所示是退色态WO 3 膜层表面微形貌像 (V_{bia} =0.332 V, I_{ref} =-1.17 nA。从 图 5 和图 6 可以看出,着色态H_{0.33}WO 3 膜层是由许多十分细小的晶粒组成,并呈柱状排列,平 均晶粒度为十几个纳米;退色态WO 3 膜层是由平均晶粒度为几十个纳米的晶粒组成,亦呈柱 状排列。STM 图像亦表明,着色态H_{0.33}WO 3 膜层与退色态WO 3 膜层比较,其表面构造较疏 松,这种排列结构可能对电致变色反应中,进入 c-WO x 膜层的 H⁺ (或Li⁺)离子在晶格间隙 的注入或晶界间隙的停留效应有利⁽¹¹⁾。由于 WO x 膜层着色态和退色态的导电性相差很 大^(12,13),因此 c-WO x 薄膜着退色状态的微形貌像的差异,也可能是膜层电导率不同所致,而 这种特性直接与膜层的物相组份晶体结构和晶体场效应相关联。薄膜着退色态的不同物相属 不同的晶系,这种变化使原子致密性有所改变,将引起晶体中电子密度分布的变化,这也将导致膜层表面微形貌 STM 图像的变化。



图 5 着色态 c-WO 2.9 膜层的表面微形貌 扫描面积:330 nm × 230nm



图 6 退色态 c-WO 3 膜层的表面微形貌 扫描面积:370 nm × 270nm

3 结 论

通过以上实验分析得出如下结论:

1. 实验中得到的WO x 膜层试样均具有电致变色效应。

2. 非晶态 a WO x 膜层的着色态和退色态仍为非晶结构。

3. 晶态 c-WO x 膜层退色态为化学计量三斜晶系的WO 3, 着色态主要为非化学计量四方 晶系的 H 0.33 WO 3, 这种物相组份的变化随 c-WO x 膜层着退色状态的变化而变化。

4. 着色态H_{0.33}WO₃ 膜层是由平均晶粒度为十几个纳米的小晶粒组成, 呈柱状排列; 退色态WO₃ 膜层是由平均晶粒度为几十个纳米的小晶粒组成, 亦呈柱状排列。退色态WO₃ 膜层 表面形貌比着色态H_{0.33}WO₃ 膜层表面形貌更致密。

参考文献

1Lampert C M , Omstead T R , Yu P C Sol Energy Mater .,1986,14:161-1742Donnadieu A , Davazoglou D , Abdellaout A. Thin Solid Films ,1988,164:333-3383Deb S K Phil. Mag .,1973,27:801-822

3683

-36

-2354

-296

4 Crandall R S, Faughnan B W. Appl. Phys. Lett., 1976, 28:95 -97

- 5 Granqvist C G. Sol. Energy Mater. Solar Cells, 1994, 32:369 -382
- 6 Green M, Karamkang. Displays ,1988,10:166 -173
- 7 Agnihotry SA, Rashmi, Ramchandran R, Chandra S Sol Energy Mater. Solar Cells, 1995, 36:289 294
- 8 殷志强,安妮,克劳斯.电子学报,1994,22 (8):76 -81
- 9 Estrada W, Andersson AM, Ganqvist CG. J. Appl. Phys., 1988, 64:3678
- 10 Nagai Junichi. Sol. Energy Mater. Solar Cells, 1993, 31:291 -299
- 11 Zhang Q, Wessel SA, Heinrich B, Colbow K. Sol Energy Mater ., 1990, 20:289
- 12 Svensson J S E M, Granqvist C G. Thin Solid Films, 1985, 126:31
- 13 Randin J P, Viennet R. J. Electrochem . Soc, 1982, 129:2349

STUDY ON THE PHASE, COMPOSITION AND SURFACE MORPHOLOGY CHANGES OF WO x FILM IN ELECTROCHROMIC STATES

Wang Xiaoguang Jiang Yueshan Yang Naiheng (Vacuum Engneering Department, Northeastern University, Shenyang 110006)

Yuan Lei Pang Shijin

(BeijingLaboratory of Vacuum Physics, Academia Sinica, Beijing 100080)

Abstract: WO x electrochromic (EC) films obtained by DC magnetron sputtering technique were investigated by XRD and STM measurements. The reversible phases changes of c-WO x film between the bleached and colored states are revealed. The study results indicate that the amorphous as deposited WO x film (a-WO x) is of amorphous microstructure both in the bleached and colored states. However, the crystal WO x (c-WO x) is stoichiometric triclinic lattice WO 3 in bleached state , and would change into nonstoichiometry tetragonal lattice H 0.33 WO 3 in colored state. The surface morphology of colored c-H 0.33 WO 3 film is very different from that of the bleached WO 3 film.

Key words: electrochromism (EC), phases and composition, surface morphology

05